

# パワー半導体材料の基板加工技術最前線

## — Si, SiC, GaN の研削・研磨 他 —

カーボンニュートラル社会の実現に不可欠なパワー半導体デバイス市場の拡大が注目されている。まず、これまで一部の特殊用途のみに搭載されてきた SiC パワーデバイスであるが、ここに来て本格普及の兆しが見えてきた。2025 年以降、多くの EV に搭載されると予測されているからである。また、2030 年頃には縦型 GaN パワーデバイスが登場してくる可能性もある。しかし、これまで圧倒的な市場を得ていたのはもちろんシリコンであり、今後もその地位は揺るがないものと思われる。そこで今回はこれらの主なパワー半導体デバイス材料の加工技術、中でも研削、研磨に焦点を当ててその分野の専門家に講演していただく。

主催：公益社団法人 砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日時：2022 年 12 月 5 日(月) 13:00~17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex（オンライン）のハイブリッド形式

会場：TKP 神田駅前ビジネスセンター5 階 カンファレンスルーム 5 C

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-1 三井住友銀行神田駅前ビル 5F

[https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda-ekimae/room\\_detail/2954/](https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda-ekimae/room_detail/2954/)

交通：JR 神田駅「東口」から徒歩 3 分

※ 講演者には開催前の状況により、対面あるいはオンラインによる講演を選択して頂きます。

※ オンラインによる参加をご希望の方には、後日、詳細情報をお知らせいたします。



13:00~13:05	開会挨拶	山田高三委員長
13:05~13:55	講演1 「半導体デバイス材料の除去加工の進化」	(株)高田工業所 阿部隣耕三氏
13:55~14:45	講演2 「パワー半導体用基板材料の研削加工」	旭ダイヤモンド工業(株) 渡邊正和氏
14:45~15:05	<休憩>	
15:05~15:55	講演3 「固定砥粒ラップ定盤による大口径 SiC ウエハの研磨」	(株)ミズホ 野副厚訓氏
15:55~16:45	講演4 「固体電解質を用いた環境調和型 ECMP による SiC の高能率平滑化」	立命館大学 村田順二氏
16:45~16:50	閉会挨拶・事務連絡	
17:10~19:10	技術交流会（予定）	

### 参加費

- ・研究会：当専門委員会会員：無料、非会員：15,000 円 ※会員は 5 人まで、非会員は 2 人まで研究会に参加できません。
- ・技術交流会：2 人/社まで無料、3 名目からは会員・非会員問わず 5,000 円/人を徴収致します。

申込締切日：2022 年 11 月 24 日(木)

(注) 当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附宙美宛

- ・ FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp
- ・ 申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>